

### Сведения о ведущей организации

Полное наименование и сокращенное наименование	Место нахождения	Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»	Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) (о сотрудниках, которые готовят отзыв ведущей организации)
<p>ФАНО России Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН)</p>	<p>Российская Федерация. Москва.</p>	<p>119991, Москва, Ленинский проспект, 31. +7(495)952-0787 <a href="mailto:info@igic.ras.ru">info@igic.ras.ru</a> <a href="http://www.igic.ras.ru">http://www.igic.ras.ru</a></p> <p><a href="mailto:izotov@igic.ras.ru">izotov@igic.ras.ru</a> <a href="mailto:mgvas@igic.ras.ru">mgvas@igic.ras.ru</a></p>	<p>1. Магнитомягкий полупроводниковый материал. В.П. Саныгин, О.Н. Пашкова, А.В. Филатов, А.Д. Изотов, В.М. Новоторцев. Патент на изобретение № 2465378. Зарегистрировано в государственном реестре изобретений РФ 27 октября 2012 г.</p> <p>2. Патент (Республика Беларусь). Способ получения монокристаллического антимонида марганца. В.М. Трухан, Т.В. Шелковая, А.Д. Изотов, М.Л. Малышев, С.Ф. Маренкин Заявитель и патентообладатель: ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению», заявл. №a20120380 от 15.03.2012.</p> <p>3. С.Ф. Маренкин, А.В. Кочура, И.В. Федорченко, А.Д. Изотов, М.Г. Васильев, В.М. Трухан, Т.В. Шелковая, О.А. Новодворский, А.Л. Желудкевич. Выращивание эвтектических композиций в системе InSb–MnSb. // Неорганические материалы. 2016. - Т.52. - №3.- С.309-314.</p> <p>4. В. П. Саныгин, А. Д. Изотов, О. Н. Пашкова, А. Е. Баранчиков, А. В. Филатов. Топографический анализ поверхности магнитного полупроводника GaSb&lt;Mn&gt; //Неорганические материалы. 2016. – Т.52. - №9.- С. 931–937.</p> <p>5. М. Г. Васильев, А. М. Васильев, В. В. Голованов, А. А. Шелякин. Создание и исследование спектральных характеристик лазерного диода для удаленного контроля метана// Неорганические материалы. 2016.- Т.52. - №9.- С. 938–941.</p> <p>6. М. Г. Васильев, А. М. Васильев, В. В. Голованов, А.Д. Изотов, А. А. Шелякин. Метод ступенчатого травления оптического волокна.// Журнал неорганической химии. 2016. Т. 61. - №9. – С. 1218–1220.</p> <p>7. В. Г. Яржемский, С. В. Мурашов, А. Д. Изотов. Электронное строение и обменное взаимодействие в магнитных полупроводниках Ga<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>As и In<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Sb.//Неорганические материалы. 2016.- Т.52. - № 2. С.119–123.</p>

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>8. С.Ф. Маренкин, А.Д. Изотов, И.В. Федорченко, В.М. Новоторцев. Синтез магнитогранулированных структур в системах полупроводник–ферромагнетик//Журнал неорганической химии. - 2015. - Т. 60.- № 3. – С. 343–348.</p> <p>9. М. Г. Васильев, А. М. Васильев, А. Д. Изотов, А. А. Шелякин. Создание и исследование высокотемпературного лазерного диода с длиной волны излучения 1310 нм на основе зарощенных гетероструктур InP/GaInAsP//Неорганические материалы, 2014. -Т 50, № 9, с. 963–967.</p> <p>10. О.Н. Пашкова, А.Д. Изотов, В.П. Саныгин, А.В. Филатов. Ферромагнетизм сплава GaSb(2% Mn)// Журнал неорганической химии. 2014. Т.59. №11. С. 1570–1573.</p> <p>11. I.V. Fedorchenko, A.N. Aronov, L.Kilanski, V. Domukhovski, A. Reszka, B.J. Kowalski, E. Lahderanta, W. Dobrowolski, A.D. Izotov, S.F. Marenkin. Phase equilibria in the ZnGeAs<sub>2</sub>–CdGeAs<sub>2</sub> system// Journal of Alloys and Compounds. 2014. Vol. 599. P.121–126.</p> <p>12. M. G. Vasil'ev, A. M. Vasil'ev, A. D. Izotov, Ya. G. Filatov, and A. A. Shelyakin. Fabrication and Parameters of a 1310 nm Buried Heterostructure Operating in the Microwave Region// Inorganic Materials, 2013, Vol. 49, No. 6, pp. 539–544.</p> <p>13. М. Г. Васильев, А. М. Васильев, А. Д. Изотов, А. А. Шелякин. Создание и исследование лазерного диода для удаленного определения концентрации метана.// Неорганические материалы. 2012. Т.48. № 3. С. 305–311.</p> <p>14. О.Н. Пашкова, В.П. Саныгин, А.В. Филатов, Н.Н. Ефимов, А.Д. Изотов. Магнитомягкий полупроводник InSb&lt;Mn,Zn&gt; с температурой Кюри 320 К.// Журнал неорганической химии. 2012. Т.57. №7. С. 1073–1075</p> |
|--|--|--|

Заверяю:  
Ученый секретарь ИОНХ РАН, д.х.н.



М.Н. Бреховских